



## 四公開特許公報(A)

昭61-4133

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)1月10日

H 01 J # H 01 J

6722-5C 6722-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

**公発明の名称** 陰極構体の製造方法

> の特 爾 昭59-123617

> > 夫

昭59(1984)6月18日 ❷出

799 発明 株式会社東芝 **伊出 額** 

姬路市余部区上余部50 株式会社東芝姫路工場内

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 井上 四代 理 人

1. 発明の名称

陰極模体の製造方法・

特許請求の範囲

ニッケルを主体とし、遠元剤として少なくとも 微量のランタンを含有する合金からなる基体金属 の表面を化学的蝕如法により租面化してのち、こ の表面に電子放射物質を被着する工程を具備する ことを特徴とする陰極機体の製造方法。

発明の詳細な説明

・〔鶏明の技術分断〕

本発明はカラーブラウン管等の電子管に使用し て好適な陰極構体の製造方法に関する。

〔発明の技術的背景とその問題点〕.

一般にカラーブラウン皆や進行波管などの電子 管に使用される陰極構体としては酸化物陰極構体 が広く使用されている。

この酸化物陰極構体においては、ランタン、マ グネンウム、ケイ素、ジルコニウム、タングステ 火等の還元剤が微量添加されたニッケル悲合金よ

りなる基体金属上に、ペリウム(Ba)。ストロン チゥム (Sː),カルシウム (Ca) 等のアルカリ土祭 金属の炭酸塩を塗布し、これを実空中で加熱分解 することにより酸化物に分解転化し、 電子放射物 質としている。 基体金属中の遺元剤は電子放射物 費を活性化させ、良好な電子放射を実現するため に消費される。

とのようにして形成される陰極構体の 1 例を次 に示す。第2図は陰極本体を示し、基体金属山が 陰極スリープ(2)の頂部内側に圧入密接され、基体 金属(1)の装面には電子放射物質はが被着されてい る。上記除低スリープ(2)は陰極本体支持筒(6)に陰 茲本体支持子(7)を介して保持されている。又、上 記陰極スリープ(2)内にはヒータ(8)が挿入固定され るものである。

カタープラウン質においては、ライフ特性がす ぐれていること、できるだけ速かに安定した画像 が得られることすなわち速動性がよいことなどが 竪望されるものであつて、それらに対しては種々 の対策が関ゼられている。例えば特開昭 58-

47,440

225528 号公報で示されたよれたとして少なくともランタンを 0.05~1.0 重量が 合有するニッケル基合金でなる監督標体を形成 特性の向上をはかつている。すなわちこの監督体は高温強度特性がすぐれているので、 100 A 以下の厚さの基体金属からなるもので試験を行っても、就験中に変形することなく、良好なライフを性が得られ、又運動性も良好である。しかの一層の時である。したはさらに特性の一層の向上が 留まれ、一層高品位の陰極媒体が要望されている。 〔発明の目的〕

本発明はこのような点にかんがみなされたもので、意元剤として少なくとも数量のランタンを含有したニッケル基合金からなる基体金属を用いた陰極体の出画時間の速動性ならびに低入力電圧時のエミッション特性を一層向上させる陰極様体の製造方法を提供することを目的とする。

## (発明の概要)

先 ず本発明者が上記の要望にこたえるべく 基体 金属についての本発明を完成した実験結果につい

化学的飲知法によるエッチング処理は次のよう にして行つた。

エッチング核の組成 (王水 (HC)+HNO<sub>3</sub>)10 ~ 20 多 酢酸 (CH; COOH) 30 ~ 70 多

ェッチング時間/温度 1~8分/15~25℃

先才基体金属の裏面全体を保護ワンクスで覆い、 製面は印刷法によつて部分的にマスキングして、 上記のエンチング液でエッチングし、次いでマス キングを除去し、上記エッチングされた個所とは 別の個所をエッチングできるように別のマスキン グを行い、エッチングをする。このような処理を くりかえして基体金属の表面を租面化した。

サンドペーパによる研摩は、基体会異を高速回転させながらサンドペーパを基体会異会面に押しつけて研摩し、基体金属の袋面を粗面化した。 これら各試料の熱容量が等しくなるように、エッテング量、研摩量ならびに無処理のものは圧延時の厚さを調整した。

このようにして形成された 6 想類の基体金属の 表面に Ba., Sr., Ca の段歌塩をそれぞれ塗布して、 て述べる。

遊休金属を形成するニッケルを主体とする合金として、(A)ニッケルを主体とし、還元剤としてラッタンを 0.5 重量が、シリコンを 0.08 重量が合有するもの、(B)ニッケルを主体とし、還元剤とし合有するもの、(B)ニッケルを主体とし、還元剤として利とし、過元剤として利力を含むし、ラッタンを含有し、カックンを含有し、カックンを含有し、カックンを含有し、カックンを含有し、カックンを含有し、カックンを含まれて、(B)サンドペーパによるエッテング処理、(B)サンドペーパによる研究処理を行わないまったく表面処理を行わないまった。 種類の監督機体を形成した。

퐞

放料套号	遊体 金属	表面処理
1 (本発明)	ランタン入り	エッチング
2	,	サンドペーパ研摩
8	,	無処理
4	ランタン合有せず	エンチング
5	•	サンドペーパ研摩
6 .	,	無処理

得られた敗極構体を配設したカラーブラウン管の 特性検査の結果を第8図と第4図に示す。

第8図は出面時間つまり速動性についての評価を示し、第4図は低入力電圧時のによっています。 様軸は何れなここの評価を共っての評価を示す。 様軸はヒータ入力電圧をそれでしたのでは、第8図の横軸はヒータ入力電圧をわれたには、第6回とを表には、第6回とがものののでは、第8図と第4図とから分ののでは、第8図と第4図とからからからからでは、まるものがもつともすぐれたのでは、まるものがもつともすが、また。

このように漫元期の種類と含有量の点からの改善に加えて基体金属の形状すなわち表面状態を改善して特性の一段の向上という要望にこたえたのが本発明の方法である。すなわち本発明の方法は、ニッケルを主体とし、産元剤として少なくとも微量のラッタンを含有する合金から板状体の基体金属を形成し、その表面を化学的触知法により種面

STATE OF THE STANDARD OF THE

一次被抗毒性病 化二氢酚 化二氯酚 化二氯酚 化二氯酚酚

化し、この租面化された表面 子放射物質を被 着する工程を具備する陰極標 (発明の実施例)

以下本発明の実施例について説明する。

実施例 1、ニッケルを主体とし、ラッタンを
0.5 重要 5、シリコンを 0.0 8 重量 5 含有する 厚さ
0.1 mmのニッケル基合金板から所銀の円板状に基
体金異を成形する。耐像性ワックス(例えばアビェソッワックス(商品名))を強布した上に上記
基体金属をその裏面をワックスに接して並らべ裏面を保護する。次いで印刷法によつて基体金属表面に同種の保護ワックスをマスクにより部分的に 強布し次に示すエッチング液に 1 ~ 8 分間受ける。

エッチング液 (王水 (HCI-HNOs) 10~20分 (液温15~25℃) 「酢酸 (CHs COOH) 30~70乡 基体金属表面は選択的に発動され凹部が形成さ

る。このときエッテング液に受ける時間を長くして3~10分間受徴し、落体金属安面の租底を10~80mとし、次いで上配例と同じように Ba、8r、Caの炭酸塩を塗布する。このようにして形成した酪塩構体も実施例 I. と同じようにすぐれた特性を示した。

なお陰極格体は第2回に示したものばかりでなく、カップ選や複スリーブ型など種々の選式のものがあつて、何れのものにも本発明に係る基体金属を配設していずれも上記したようなすぐれた特性を示すものである。

## [発明の効果]

以上のように本発明の方法によつて形成された 基体金異を有する機能構体を配設したたとえばカ ラープラウン管では、良好な面像が得られる出面 時間の速効性が従来のものよりもさらに良くなり 又、低入力電圧時のエミッション特性も一層向上 するなど製品特性の改善がはかられ、本発明の方 法は工業的に有用な陰極構体の製造方法である。

4. 図面の簡単な説明

ない部分を上記と同なりにのでクタスを部分的に登布し、少しをかえてエッチングではによりな処理をくりかえして、部分的に受触度が異なる5~10年の租底を有する表面の基体を関が得られる。これを充分に洗浄してのち、水素処理を行ない、強信根体がでBa、8r、Caの設度を第1図に示す。第1図に示す。第1図により、である。その概要を第1図に示す。第1図により、第1図には、その表面が租面化され、その上に電子放射物質(3)が生布されている。

本発明の協働体体は、第8図ならびに第4図の 曲線(1)に示したものと同じ特性を示した。例えば 速助性においてはランタン入りのニッケル券合金 からなるものよりも表面を粗面化したので約1秒 よくなつた。

実施例 2、ニッケルを主体とし、ランタンを 0.5 重量 5、シリコンを 0.0 2 重量 5 含有するニッケル基合金からなる厚さ 0.1 mm の基体金属を形成 し、実施例 1.と同じよりにその袋面を選択受蝕す

第1 図は本発明の基体金属の取着された陰極本体の概略を示す断面図、第2 図は陰極機体を示す 断面図、第3 図は速動性を示す曲線図、第4 図は 低入力電圧時のエミッション特性を示す曲線図で ある。

1 … 基体金属、2 … 陰極スリーブ、8 … 電子放射物質。

代理人 弁理士 井 上 一 男







